

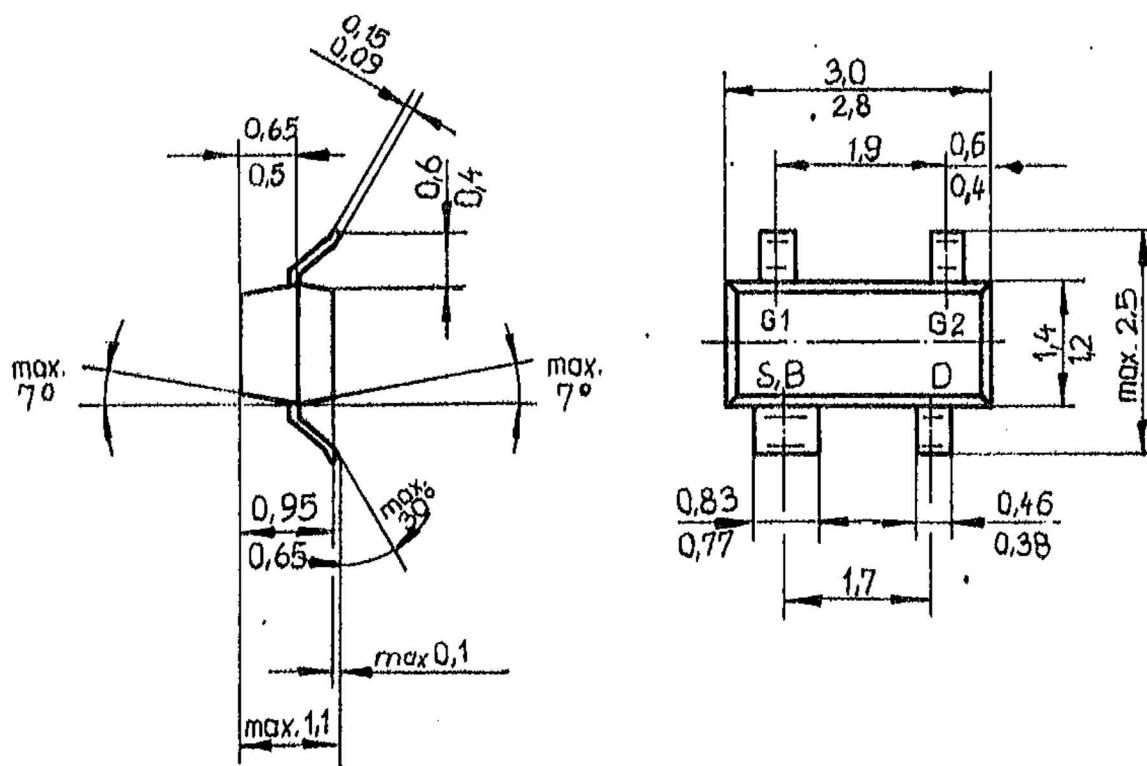
SME 992

SME 994

SME 996

N-Kanal-MOS-Feldeffekttransistoren-Tetroden

* In Entwicklung *



Maßbild mit Anschlußbelegung

Wärmewiderstände: $R_{thja} \leq 0,46 \text{ K/mW}^1)$

N-Kanal-MOS-Feldeffektransistoren-Tetroden vom Verarmungstyp (depletion) mit integrierten Schutzdioden
SME 992 für UKW-Anwendungen

SME 994 für VHF-Anwendungen

Grenzwerte (gültig für den Betriebstemperaturbereich) SME 996 für UHF-Anwendungen

	SME 992	SME 994	SME 996	Einheit
U_{DS}	20	20	20	V
I_{DAV}	40	30	30	mA
$\pm I_{G1S}$	10	10	10	mA
$\pm I_{G2S}$	10	10	10	mA
P_{tot} ($T_a \leq 60^\circ\text{C}$) ¹⁾	200	200	200	mW
T_c	150	150	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55 bis 125	-55 bis 125	-55 bis 125	$^\circ\text{C}$

1) Transistor auf Keramiksubstrat $8 \times 10 \times 0,6 \text{ mm}^3$

Statische Kennwerte ($T_a = 25^\circ C$)

	SME 992	SME 994	SME 996	Einheit
$\frac{+}{-} I_{G1SS}$ ($- U_{G1S} = 5 \text{ V}$, $U_{G2S} = U_{DS} = 0 \text{ V}$)	≤ 50	≤ 50	≤ 50	nA
$\frac{+}{-} I_{G2SS}$ ($- U_{G2S} = 5 \text{ V}$, $U_{G1S} = U_{DS} = 0 \text{ V}$)	≤ 50	≤ 50	≤ 50	nA
I_{DSS} ($U_{DS} = 10 \text{ V}$, $U_{G2S} = 4 \text{ V}$)	1 bis 25			mA
$(U_{DS} = 15 \text{ V},$ $U_{G2S} = 4 \text{ V})$		2 bis 20	2 bis 20	mA
$-U_{G1S(OFF)}$ ($U_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 20 \mu\text{A}$ $U_{G2S} = 4 \text{ V}$)	$\leq 1,3$			V
$(U_{DS} = 15 \text{ V},$ $I_D = 20 \mu\text{A}$ $U_{G2S} = 4 \text{ V})$		$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	V
$-U_{G2S(OFF)}$ ($U_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 20 \mu\text{A}$, $U_{G1S} = 0 \text{ V}$)	$\leq 1,1$			V
$(U_{DS} = 15 \text{ V},$ $I_D = 20 \mu\text{A}$, $U_{G1S} = 0 \text{ V})$		$\leq 2,0$	$\leq 2,0$	V

Dynamische Kennwerte ($T_a = 25^\circ C$)

	SME 992	SME 994	SME 996	Einheit
$ Y_{21S} $ ($U_{DS} = 10 \text{ V}$, $U_{G2S} = 4 \text{ V}$, $I_D = 15 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ KHz}$)	≥ 20			mS

	SME 992	SME 994	SME 996	Einheit
$ Y_{21S} $ ($U_{DS} = 15 \text{ V}$, $U_{G2S} = 4 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ KHz}$)		≥ 15	≥ 15	mS
G_p ($U_{DS} = 15 \text{ V}$, $U_{G2S} = 4 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$, $f = 200 \text{ MHz}$, $G_g = 2 \text{ mS}$, $G_l = 0,5 \text{ mS}$)		≥ 20		dB
F ($U_{DS} = 10 \text{ V}$, $U_{G2S} = 4 \text{ V}$, $I_D = 15 \text{ mA}$, $f = 200 \text{ MHz}$, $G_g = 2 \text{ mS}$)	$\leq 2,5$		≥ 15	dB
G_g ($U_{DS} = 15 \text{ V}$, $U_{G2S} = 4 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$, $f = 200 \text{ MHz}$, $G_g = 2 \text{ mS}$)		$\leq 2,8$		dB
G_g ($U_{DS} = 15 \text{ V}$, $U_{G2S} = 4 \text{ V}$, $I_D = 10 \text{ mA}$, $f = 800 \text{ MHz}$, $G_g = 2 \text{ mS}$)			$\leq 3,9$	dB